

Коаксиальный PIN-диод InGaAs

Особенности:

Высокая чувствительность, низкие обратные потери, малый темновой ток, коаксиальный пакет с малой емкостью, лазерная сварка

Применение:

Аналоговый оптический приемник

Испытательное оборудование

Технические характеристики**А б с о л ю т н ы е м а к с и м а л ь н ы е р е й т и н г и**

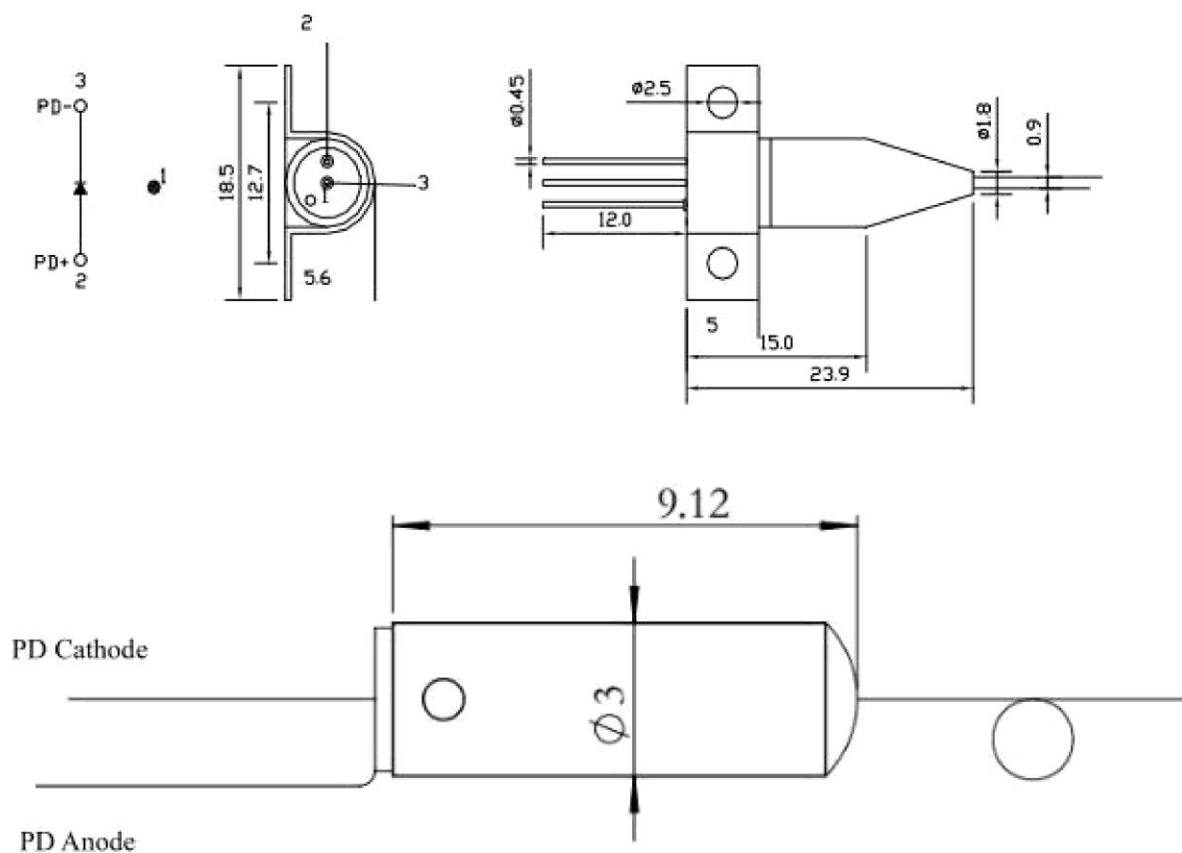
П а р а м е т р	С и м в о л	Р е й т и н г и	Е д и н и ц а
М о щ н о с т ь н а с ы щ е н и я	П с	5	м В т
П р я м о й т о к	л ф	10	м А
О б р а т н о е н а п р я ж е н и е	В р	30	В
О б р а т н ы й т о к	Л р	5	м А
Р а б о ч а я Т е м п е р а т у р а	В е р х н я я	-40 - +85	С
Т е м п е р а т у р а х р а н е н и я	Ц Т Г	-40 - +85	С

О п т и ч е с к и е и э л е к т р и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и(T_c=25° С)

П а р а м е т р	С и м в	М и	Т и	М а	Е д	У с л о в и я
Р а б о ч а я д л и н а в о л н ы	И к с	1100		1650	н м	
О т з ы в ч и в о с т ь	р	0,85	0,90		А / В	В р = -5 В, X=1310 н м
		0,90	0,95			В р = -5 В, X=1550 н м
Т е м н ы й п о т о к	И д е н т и ф и		0,2	0,5	н А	В р = 5 В
Е м к о с т ь	С		0,6	0,75	П Ф	V _r =5V, f=1MHz, к о р п у с о т к р ы т
В р е м я н а р а с т а н и я / в р е м я	Т р / Т ф			0,3	н с	В р = 5 В, 10-90%
П р о п у с к н а я с п о с о б н о с т ь	ч б	2,5			Г Г ц	V _r 5 В, V _r 5 В, 50 О м п л о х о й с у ч а с т и е м д л и н а
К о м п о з и т н ы й б и т в т о р о г о п о р я д к а	О Г О	-	-70	-	д Б	П р и м е ч а н и е 1
К о м п о з и т н ы й б и т т р е т ь е г о п о р я д к а	С Т В	-	-80	-	д Б	П р и м е ч а н и е 1
Р а б о ч е е н а п р я ж е н и е	В	-	-5	-	В	
О п т и ч е с к и е о б р а т н ы е п о т е р и	Р Л	-	-45	-	д Б	X= 1310 н м

Коаксиальный PIN-диод InGaAs

Размеры упаковки



Заказ	Информация							
ПД	Площадь	Получать	00	Упаковка	Косичка	Волокно	длина	Соединитель
	ь	Длина волны		а				ь
	80=80 1H=10 0	1315=1100-1 650 0850=400-11 00		1=5,6 x24 2=3,0 x15,6	0=250 мкм голое волокно 1=0,9 мм свободная трубка	1=SMF -28e	1=1м S=Указать	0=Нет 1=FC/СКП 2=FC/БТР 3=СК/БТР 4=СК/СКП 5=МУ 6=ЛК/СКП 7=ЛК/БТР